



# Saad Eddine KHEMISSI


Maître de conférences classe A

## PROFIL

---

 Département des Sciences de la Matière

 Khemissi.saadeddine@univ-khenchela.dz

 0662559694

---

## LANGUES

---

Arabe 

Anglais 

français 



## FORMATION

**1999**

Diplôme d'Etudes Supérieures en Physique du solide.  
*Université de Constantine*

**2003**

Diplôme de Magister en Physique des Semi-conducteurs.  
*Université de Constantine*

**2009**

Diplôme de Doctorat en Physique des Semi-conducteurs.  
*Université de Constantine*

**2013**

Habilitation universitaire en Physique des matériaux.  
*Université d'Oum El Bouaghi*

**Maître de conférences classe A**

**Université Abbes Laghrour Khenchela**

**1- N. Merabtine, S. Khemissi, M. Zaabat, M. Belgat, C. Kenzai**

**« Accurate numerical modelling of GaAs MESFET current-voltage characteristics »**

**Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics, Vol 7, N°4 pp 389-394. 2004.**

**[http://journal-spqeo.org.ua/n4\\_2004/389\\_394.htm](http://journal-spqeo.org.ua/n4_2004/389_394.htm)**

**2- S. Khemissi, N. Merabtine, M. Zaabat, C. Kenzai, Y. Saidi, S. Amourache.**

**« Influence of physical and geometrical parameters on electrical properties of short gate GaAs MESFETs », Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics, Vol 9, N°2 pp 34- 39, 2006.**

**[http://journal-spqeo.org.ua/n2\\_2006/P034-039.htm](http://journal-spqeo.org.ua/n2_2006/P034-039.htm)**

**3- S. Khemissi, C. Azizi**

**"A Two-Dimensional Analytical Modeling of the Current-Voltage Characteristics for submicron Gate-Length GaAs MESFET's", International Journal of Engineering & Technology IJET-IJENS, Vol: 12, N°: 04, pp. 27-33, 2012.**

**[http://ijens.org/Vol\\_12\\_I\\_04/126104-7373-IJET-IJENS.pdf](http://ijens.org/Vol_12_I_04/126104-7373-IJET-IJENS.pdf)**

**4- C. Kaddour, C. Azizi, S. Khemissi, M. Zaabat et Y. Saidi.**

**« Analytical Model for GaAs MESFET with High Pinchoff Voltage”, Journal of Materials Science and Engineering A 3 Vol 12 pp. 853-858, 2013.**

**5- S. Kattar, S. Khemissi,**

**« I-V Characteristics Modeling of the Carbon Nanotube Field Effect Transistor (CNTFET)», Jordan Journal of Physics, Vol 15, N 3, pp. 279-288, 2022**

**6- M. Droudj, S. Khemissi,**

**« Modeling and Simulation of Current Voltage Characteristics for Cylindrical CNTFET Transistor», Jordan Journal of Physics, Vol 16, N 5, pp. 517-526, 2023.**